一种Al-O-N扩散阻挡层及制备方法

文献类型：专利

作者 孙超, 王启民, 李伟洲, 姚勇, 鲍泽斌, 刘山川, 宫骏 and 闻立时

发表日期 2008-12-03

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及涂层技术,具体地说是一种Al-O-N扩散阻挡层及制备方法,与 MCrAlY(M = Ni,Co或Ni+Co)防护涂层结合应用； 采用电弧离子镀技术,以 纯铝为靶材,控制反应过程中O_2和N_2的流量,在高温合金基体上沉积Al-O-N 扩散阻挡层,然后采用电弧离子镀技术沉积MCrAlY涂层。本发明所涉及的这种 Al-O-N扩散阻挡层,组织致密,与基体结合良好,在高温氧化条件下能有效降低 MCrAlY涂层与高温合金基体间金属元素互扩散,改善MCrAlY涂层的高温性能； 而且工艺简单,容易实现工业化生产,是一...

公开日期 2008-12-03

语种 中文

专利申请号 CN101314853

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/66449]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 GB/T 7714 孙超, 王启民, 李伟洲, 姚勇, 鲍泽斌, 刘山川, 宫骏 and 闻立时. 一种Al-O-N扩散阻挡层及制备方法. 2008-12-03.

入库方式： OAI收割
来源：金属研究所

浏览 143 下载 0 收藏 0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。